

2027年3月期 第2四半期（2026年7月～9月） 東京エレクトロン 決算説明会

2026年10月30日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員・CFO）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替変動について

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれており、一部に外貨建の売上および費用計上があります。各国・地域における経済環境、国際情勢、金利変動等の要因により、急激な為替変動があった場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

2027年3月期 第2四半期 連結決算の概要

2026年10月30日

常務執行役員・CFO
川本 弘



改めまして、川本でございます。
私から、2027年3月期、第2四半期連結決算の概要をご説明いたします。

損益状況（四半期）

(億円)

	FY2026			FY2027		vs.	vs.
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	FY2027 Q1	FY2026 Q2
売上高	6,300	5,520	7,118	7,323	9,350	+27.7%	+48.4%
売上総利益	2,848	2,358	3,331	3,427	4,473	+30.5%	+57.0%
売上総利益率	45.2%	42.7%	46.8%	46.8%	47.8%	+1.0pts	+2.6pts
販管費	1,264	1,196	1,275	1,313	1,520	+15.8%	+20.2%
営業利益	1,584	1,161	2,056	2,114	2,953	+39.7%	+86.4%
営業利益率	25.1%	21.0%	28.9%	28.9%	31.6%	+2.7pts	+6.5pts
税金等調整前当期純利益	1,610	1,533	2,818	2,154	2,922	+35.6%	+81.5%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,238	1,185	2,142	1,643	2,125	+29.4%	+71.7%
研究開発費	726	662	767	720	852	+18.4%	+17.3%
設備投資額	912	303	416	399	323	-18.9%	-64.5%
減価償却費	191	211	235	225	243	+8.3%	+27.5%

1. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。
2. FY2026は2025年4月～2026年3月の会計年度を指しています。FY2027は2026年4月～2027年3月の会計年度を指しています。

こちらは、四半期ごとの「損益状況」です。青枠の部分を中心にご覧ください。

第2四半期の売上高は、活発な市況を背景に、前四半期比27.7%増加し、過去最高となる9,350億円を達成しました。

売上総利益は、前四半期比30.5%増加の4,473億円。

売上総利益率は、売上高増加による固定費比率の減少により前四半期比1.0ポイント増加の47.8%となりました。

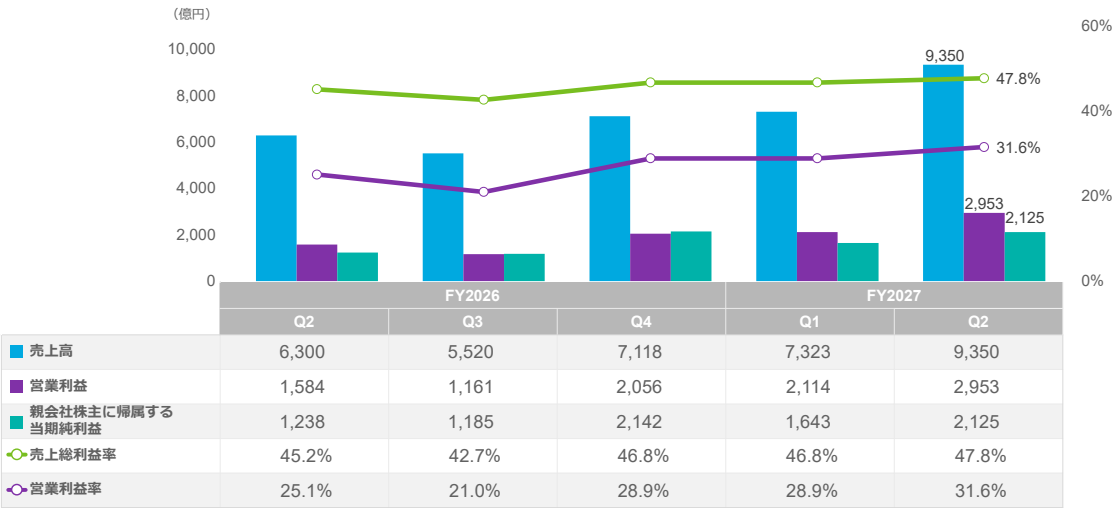
営業利益は、前四半期比39.7%増加の、2,953億円。

営業利益率は、前四半期比2.7ポイント増加の31.6%となりました。

税金等調整前当期純利益は、前四半期比35.6%増加の2,922億円、また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前四半期比29.4%増加の2,125億円となりました。

第2四半期の設備投資額は323億円でした。

損益状況（四半期）



こちらのグラフは、先ほどご説明させていただいた業績を時系列で示しておりますので、ご確認ください。

損益状況（半期）

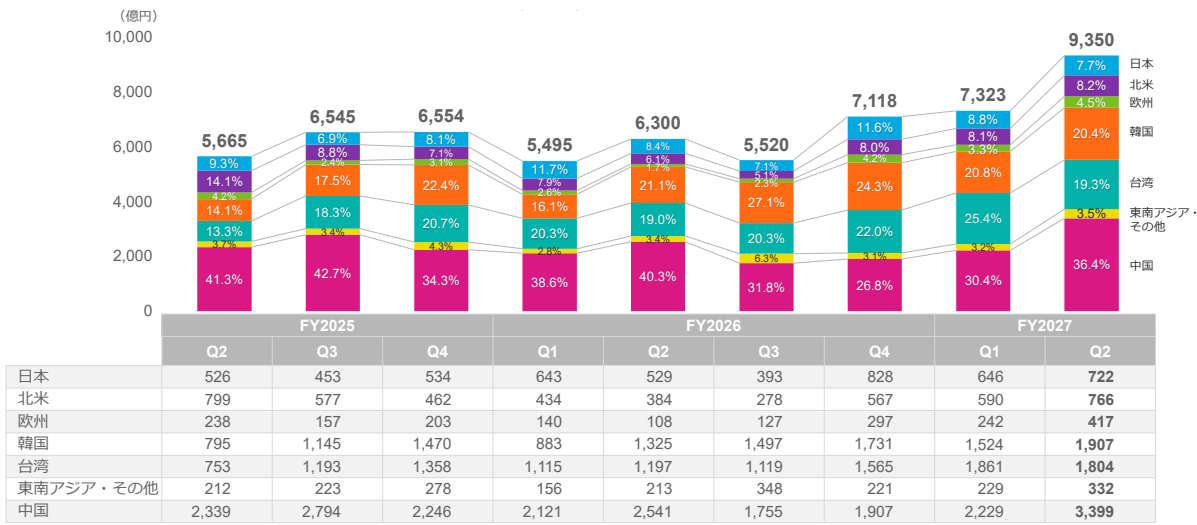
(億円)

	FY2026		FY2027	vs. FY2026 H2	vs. FY2026 H1	(ご参考) 7月30日発表 FY2027 H1 予想
	H1	H2	H1			
売上高	11,796	12,638	16,674	+31.9%	+41.3%	16,200
売上総利益	5,388	5,690	7,901	+38.9%	+46.6%	7,480
売上総利益率	45.7%	45.0%	47.4%	+2.4pts	+1.7pts	46.2%
販管費	2,357	2,472	2,833	+14.6%	+20.2%	2,900
営業利益	3,031	3,217	5,067	+57.5%	+67.2%	4,580
営業利益率	25.7%	25.5%	30.4%	+4.9pts	+4.7pts	28.3%
税金等調整前当期純利益	3,129	4,351	5,077	+16.7%	+62.2%	4,640
親会社株主に帰属する当期純利益	2,416	3,328	3,769	+13.3%	+56.0%	3,490
研究開発費	1,348	1,430	1,573	+10.0%	+16.7%	1,600
設備投資額	1,440	719	723	+0.5%	-49.8%	-
減価償却費	362	447	468	+4.9%	+29.2%	-

1. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

こちらは半期ベースの業績を示しております。
青枠で囲っている箇所が、今上期の損益状況でございます。
半期ベースで、売上高、売上総利益、営業利益、営業利益率、当期純利益は過去最高となりました。
一番右に、7月30日に発表しました今上期の業績予想数値を表示しております。
ご覧のとおり、計画を上回る結果となりました。

地域別売上高構成比（四半期）



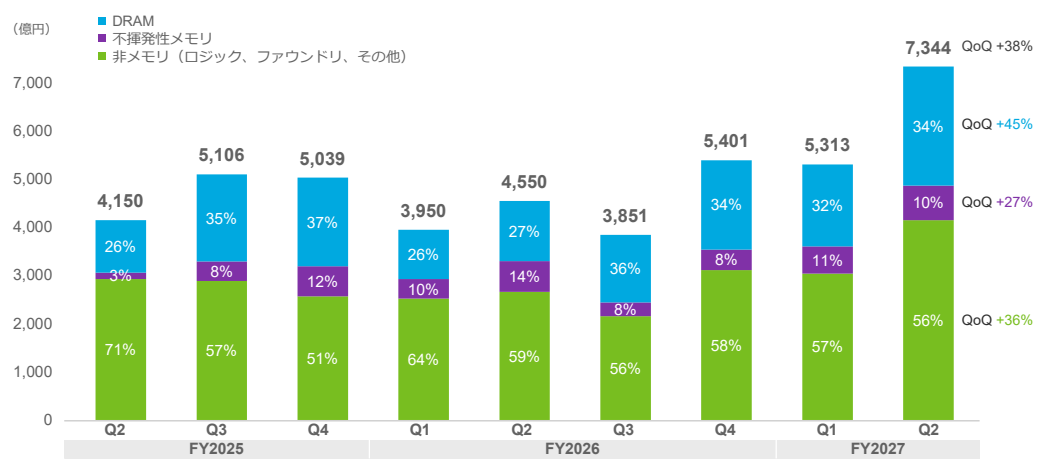
Investor Relations / October 30, 2026

TEL

7

こちらは、「地域別売上高」です。
韓国、台湾向けの売上は引き続き堅調でした。
また、中国については、大手顧客の投資が活況であったため、構成比は、前四半期比6ポイント増加し36.4%となりました。
なお、7月の第1四半期決算説明会でもお伝えしております通り、2027年3月期通期では、中国向け構成比は30%台前半になる見込みです。

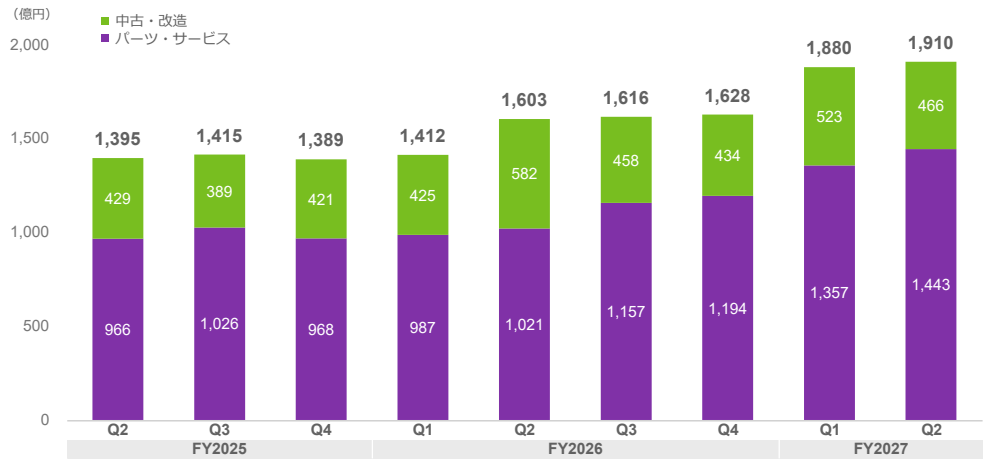
SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置
 2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

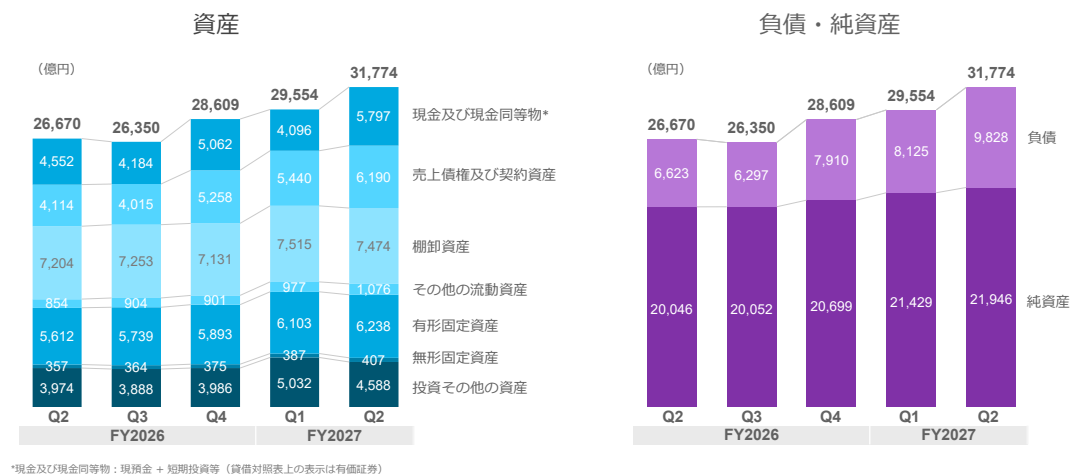
こちらは、「SPE新規装置のアプリケーション別 売上構成比」です。
 第2四半期の構成比は、上からDRAM34%、不揮発性メモリが10%、非メモリが56%となりました。
 グラフの右に記載しております通り、全てのアプリケーションにおいて前四半期比で成長が見られましたが、特に、DRAM向けは前四半期比45%増加と非常に力強い伸びを示しました。

フィールドソリューション売上高（四半期）



こちらは、「フィールドソリューションの売上高」です。
 第2四半期は、前四半期から1.6%増加し、1,910億円となりました。
 顧客工場の高い稼働水準の維持に向けたニーズが引き続き強く、パーツ・サービスが
 前四半期比6.4%増加と6四半期連続成長し、フィールドソリューション全体の成長を
 支えました。

貸借対照表（四半期）



続きまして、「貸借対照表」をご説明いたします。

資産合計は、3兆1,774億円となりました。

現金同等物は、5,797億円。前四半期から1,701億円増加いたしました。

売上債権及び契約資産は、前四半期比750億円増加の6,190億円。

棚卸資産は、前四半期比40億円減少の7,474億円、前期に引き続き回転日数は改善しました。

有形固定資産は、前四半期から134億円増加し、6,238億円となりました。

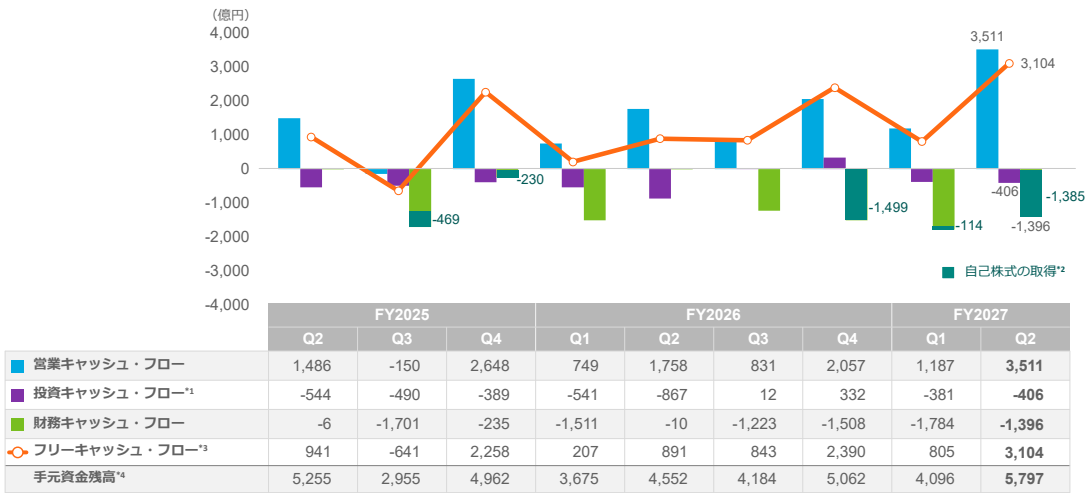
投資その他の資産は、前四半期から444億円減少し、4,588億円となりました。主に、投資有価証券の時価評価による影響です。

続いて、右側の負債・純資産でございますが、負債は、前四半期から1,703億円増加の9,828億円となりました。

業績に連動した、未払法人税等・賞与の引き当ての増加が背景でございます。

純資産は、前四半期比517億円増加の2兆1,946億円となりました。

キャッシュ・フロー（四半期）



^{*1} 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。
^{*2} 自己株式の取得は、当期末当株式の買取りに要した金額を除いた金額です。
^{*3} フリーキャッシュ・フロー＝営業キャッシュ・フロー＋投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）
^{*4} 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3か月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

続きまして、「キャッシュ・フロー」をご説明いたします。
この四半期における営業キャッシュ・フロー獲得は、3,511億円ございました。
投資キャッシュ・フローは、406億円の支出となりました。
財務キャッシュ・フローの支出は、主に自己株式の取得により、1,396億円。
また、フリーキャッシュ・フローは、3,104億円の収入となりました。
私からのご説明は以上です。ありがとうございました。

事業環境および業績予想

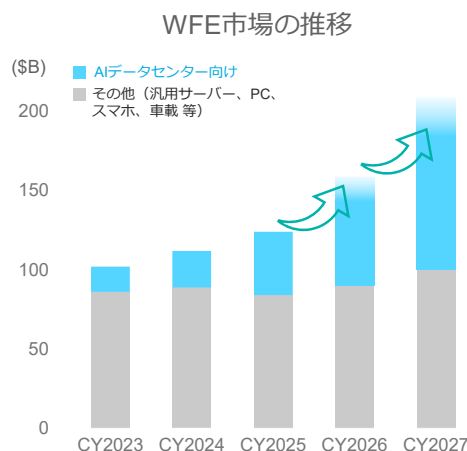
2026年10月30日

代表取締役社長・CEO
河合 利樹



皆さま、改めまして、河合でございます。
わたくしからは、「事業環境および業績予想」について、ご説明致します。

事業環境（2026年10月時点でのWFE市場の見方）



WFE市場の見通し

- CY2026：\$160B程度
- CY2027：\$210B以上
- 生成AIに加え、エージェント型AIの普及が、**先端半導体の需要拡大を加速**
 - **GPU/HBM**：演算量・データ量の増加に対応
 - **CPU**：演算の前処理やGPUへのデータ供給、周辺機器の制御などにより、必要数が増加
 - **DRAM**：CPU・GPU周辺で一時保存するデータの増加に伴い、必要容量が拡大
 - **NAND**：AIモデルや大規模データの保存により、サーバー当たりのストレージ容量が拡大

トークン量の増加・演算の複雑化が、AIインフラ全体の半導体需要を牽引

Investor Relations / October 30, 2026

TEL

13

まず、「事業環境」について、ご説明します。

WFE市場については、足元の非常に強い需要を反映し、今年、CY2026は160Bドル程度、来年、CY2027は210Bドル以上と、7月末の予想から、見通しを更新いたしました。

両年とも、前年比30%程度の成長を見込んでおります。

AIの進化は、半導体市場全体の成長機会をさらに広げています。生成AIに加え、エージェント型AIの普及に伴い、AIが自律的に複数のタスクを実行するようになり、処理するトークン数は大きく増加します。

そのため、GPUではより高い演算能力、HBMではKVキャッシュを支える大容量・広帯域化が必要になります。

さらに、前処理や制御を担うCPU、長いコンテキストを支えるDRAM、モデルやデータ、推論の処理履歴を保存するNAND・SSDなど、需要は幅広いデバイスに波及していきます。

これまで、コンピューティングの性能向上は、主にCPUやGPUといったロジック半導体の演算性能に牽引されてきました。

しかしAIの時代になると、演算能力だけではなく、大量のデータを保持し、いかに早くGPUに供給できるかが、システム全体の性能を大きく左右するようになります。

そのため、DRAMやHBMを中心とするメモリの役割も大きく変化しています。

メモリはデータを「記憶する」存在から、AIの性能を支える中心的なコンポーネントの一つへと、その役割を広げています。

More tokens, More semiconductors. AIが高度化するほど、必要な演算能力に加え、メモリ容量や帯域も増えていきます。

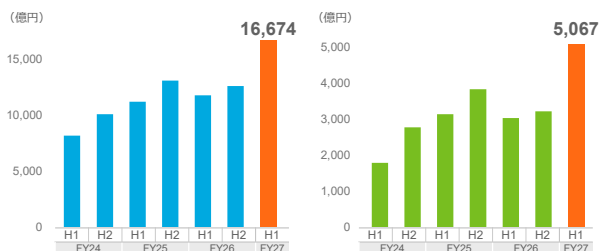
そして、半導体の量が増え、技術的な難易度も上がる。それが、WFEのさらなる成長につながると考えています。

2027年3月期上期 事業概況

- 旺盛な需要を背景に、
半期で過去最高の業績を達成

売上高 1.6兆円

営業利益 5,067億円



- 塗布現像装置・洗浄装置ビジネスユニット：
熊本地方の震災影響に迅速に対応し、
上期売上高は前下期比 +50%超を達成

Investor Relations / October 30, 2026



次に、「2027年3月期上期の事業概況」についてご説明します。

旺盛なWFE需要に支えられ、今上期売上高は1兆6,674億円となり、半期で過去最高の売上高となりました。

特に、塗布現像装置・洗浄装置ビジネスユニットの上期売上高は、前下期比50%以上の増加となりました。

同ビジネスユニットは、当社の主力工場の1つである九州熊本工場を拠点としておりますが、本年7月の熊本地方における地震発生を受け、迅速な対応を進め、このような成果を達成することができました。

当社の強みのひとつである、サプライチェーン全体での総合的な対応力が、まさに活かされた一例であり、ご協力をいただきましたすべてのステークホルダーの皆様に、心より感謝申し上げます。

2027年3月期上期 事業進捗・製品展開

エッチング

DRAMキャパシタ マスク工程（コンダクタエッチング）

DRAM現行世代で広く採用されているキャパシタモールド（絶縁膜エッチング）に加え、先端世代でマスク工程のPOR^{*1}を1社で獲得

NANDチャネルホール（絶縁膜エッチング）

極低温エッチング装置の量産受注が順調に進捗

成膜

コンタクトメタル（枚葉CVD）

最先端ロジックにおける新工程の開発POR獲得に成功

Deep Trench Capacitor High-k（バッチALD）

先端パッケージング向けで需要拡大。今期・来期とも200台以上の出荷を見込む

プローバ

先端ロジックシェアNo.1

増加するテスト需要を取り込み、前期比約60%増の記録的な出荷台数を見込む

PIC^{*2}における、光・電気統合テストも量産拡大

^{*1} POR: Process of Record

^{*2} PIC: Photonic Integrated Circuit

Investor Relations / October 30, 2026



次に、「上期の事業進捗および製品展開」についてご説明します。

今上期も、将来の売上成長に寄与する先端領域におけるPORの獲得が、順調に進捗しました。

エッチングについては、既に高いシェアを保持するDRAMキャパシタ・モールド工程に加え、新たに、キャパシタ・マスク工程でPORを獲得しました。長年取り組んできたコンダクタエッチングにおいて、初のDRAMでの工程獲得となります。

また、NANDチャネルホール向け極低温エッチングの量産受注も順調に進捗しており、CY2027、2028に向けた追加のお引き合いも数多くいただいております。

成膜においても、さまざまなアプリケーションでの進捗が見られます。ロジックでは、最先端ノード向けコンタクトメタルやメタルキャップ工程で、枚葉CVDの新製品展開が順調に進んでいるほか、アドバンストパッケージング用途のDeep Trench Capacitor向けHigh-kバッチALDでも、売上げを伸ばしています。

プローバについては、先端ロジックにおいて圧倒的なシェアを保有しておりますが、増加するテスト需要を取り込み、今期の装置出荷台数は前年比約60%増となる見込みです。

この先も、さらなる増産に努めてまいります。

また、シリコンフォトニクス向けプローバにおいては、光と電気の統合テストを、ウェーハレベルで実施する技術が必要ですが、先端ロジックで培ったウェーハ測定技術を活かしてPORを獲得しており、今後の売上貢献が期待されます。

2027年3月期 業績予想

(億円)

	FY2026 (実績)	FY2027			
		H1 (実績)	H2 (予想)	通期 (予想)	vs FY2026
売上高	24,435	16,674	20,325	37,000	+51.4%
売上総利益	11,078	7,901	9,818	17,720	+59.9%
売上総利益率	45.3%	47.4%	48.3%	47.9%	+2.6pts
販管費	4,829	2,833	3,196	6,030	+24.9%
研究開発費	2,778	1,573	1,776	3,350	+20.6%
研究開発費以外の販管費	2,050	1,259	1,420	2,680	+30.7%
営業利益	6,249	5,067	6,622	11,690	+87.1%
営業利益率	25.6%	30.4%	32.6%	31.6%	+6.0pts
税金等調整前当期純利益	7,481	5,077	6,642	11,720	+56.6%
親会社株主に帰属する当期純利益	5,744	3,769	4,880	8,650	+50.6%
1株当たり当期純利益 (円)	250.91	166.13		381.69	+130.78

- 当社は2026年10月1日を効力発生日として1株を5株に株式分割しております。
- 1株当たり当期純利益は、FY2026の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。

FY2027通期予想は売上高・利益のすべてで過去最高を見込む

次に、「業績予想」についてご説明します。

旺盛なAIサーバー向け需要を背景に、足元では、顧客からの納期前倒しや追加購入の要請が続いています。

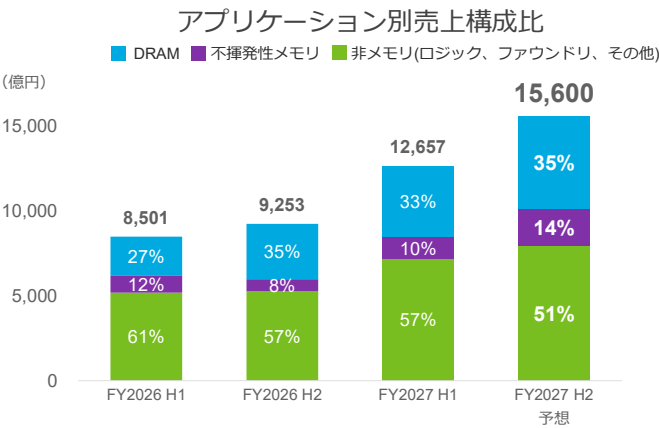
今上期は、売上高、営業利益、営業利益率ともに過去最高を更新しましたが、今下期は、さらなる記録を達成する見込みです。

2027年3月期通期の業績予想は、売上高3兆7,000億円、売上総利益1兆7,720億円、営業利益1兆1,690億円となります。

営業利益は前年比87%の増加となり、初めて1兆円を超える水準となります。

また、今下期の売上高は2兆円を超える水準と予想しておりますが、そのキャパシティについては確保できております。

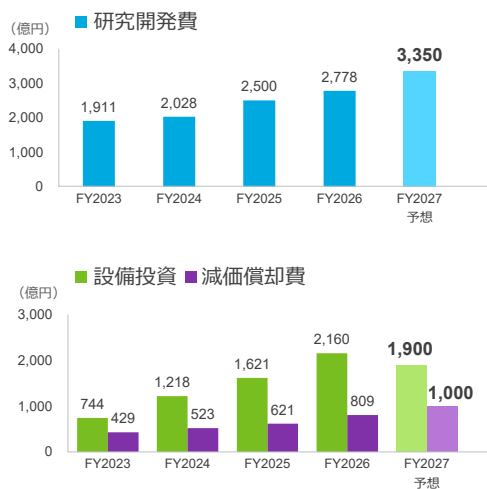
2027年3月期 SPE新規装置売上予想



下期のSPE新規装置売上は1兆5,600億円を見込む
FY2027通期のSPE新規装置売上は前期比 +59%成長

こちらは、「SPE新規装置の売上予想」です。
今上期の実績は、1兆2,657億円、今下期は、1兆5,600億円を予想し、通期では、前期比59%増と大幅な成長を想定しております。
アプリケーションごとの内訳は、ご覧の通りです。

2027年3月期 研究開発費・設備投資計画



次に、「研究開発費と設備投資の計画」についてです。

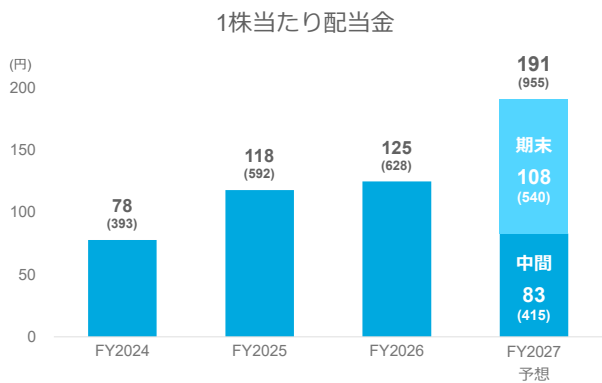
2027年3月期の研究開発費は、通期3,350億円を計画しており、技術競争力の源泉となる研究開発を積極的に推進し、半導体の技術革新を支えてまいります。

設備投資は、通期1,900億円を予定しております。

前期には、宮城の第3開発棟、熊本のプロセス開発棟、岩手の東北生産・物流センターを竣工いたしました。が、来年夏には、いよいよ、今後の大きな需要拡大を想定して着工していた宮城生産革新センターが竣工します。

下の写真は、現在の工事の様子です。計画通り、順調に建設が進んでおります。

2027年3月期 配当予想



当社は2026年10月1日を効力発生日として1株を5株に株式分割しております。
FY2024～2026の年間配当およびFY2027の中間配当の1株当たり配当金は、FY2024の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。
株式分割を考慮しない金額を（ ）内で記載しています。

当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金10円*を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

*2026年10月1日付の株式分割により、従来の50円から変更しています。

1株当たり通期配当予想は過去最高の191円

次に、「配当予想」についてです。
今回発表した通期業績予想に基づく、1株当たりの配当予想は、過去最高となる通期191円となります。
2026年5月29日発表のとおり、当社は10月1日を、効力発生日として、1株を5株に株式分割しております。
ご参考までに、株式分割を考慮しない1株当たり配当金は955円となります。

自己株式の取得について

最大1,500億円の自己株式取得枠を設定

■ 取得対象株式の種類	当社普通株式
■ 取得し得る株式の総数	2,500万株（上限） （自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 1.1%）
■ 株式の取得価額の総額	1,500億円（上限）
■ 取得する期間	2026年11月1日～2027年3月31日

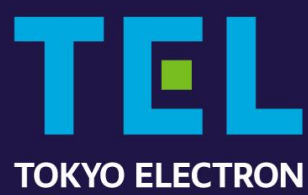
拡大する当社の事業機会とキャッシュ創出力、資本効率の向上を考慮し、
適切なバランスシート・マネジメントを実施

最後に、本日の取締役会において、1,500億円を上限として自己株式の取得枠を設定いたしました。

拡大する当社の事業機会から想定されるキャッシュ創出力、および、キャッシュポジションや資本効率の向上等を総合的に勘案したことによるものです。

今後も、適切なバランスシート・マネジメントをおこなってまいります。

私からのご説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。



本資料の取扱上の注意

当社の書面による承諾なしに複写、または
第三者への開示はできません。

東京エレクトロン

 および“TEL”は、東京エレクトロン株式会社の商標です。